

固体辐射物理研究室知识库

ALL

精确检索请加双引号

Go

首页 | 研究单元&专题 | 作者 | 文献类型 | 学科分类 | 知识图谱 | 新闻&公告

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法

郑齐文; 崔江维; 李小龙; 魏莹; 余学峰; 李豫东; 郭旗

2021-01-12

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法, 该方法包括总剂量效应关联工艺参数确定、晶体管总剂量辐照试验、晶体管电参数退化方程参数提取、不同工艺角晶体管总剂量效应模型生成、不同工艺角电路仿真。该方法的理论基础是晶体总剂量辐射损伤与工艺波动参数相关, 总剂量辐射效应与工艺波动存在耦合效应。该方法的优势在于考虑总剂量效应与工艺波动耦合, 准确仿真辐射环境工作集成电路特性。

申请日期 2020-10-20

申请号 CN202011125363.X

公开(公告)号 20210112

代理机构 65106 乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙)

文献类型 **专利**

条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8074>

专题 固体辐射物理研究室

推荐引用方式 郑齐文,崔江维,李小龙,等. 一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法. 20210112[P]. 2021-01-12. GB/T 7714

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

- ★ 保存到收藏夹
- 👁 查看访问统计
- 📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

- 📖 谷歌学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

百度学术

- 📖 百度学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

必应学术

- 📖 必应学术中相似的文章
- 📖 [郑齐文]的文章
- 📖 [崔江维]的文章
- 📖 [李小龙]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

